

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有權機關
國際事務局



G00001



(43) 國際公開日
2003 年 1 月 30 日 (30.01.2003)

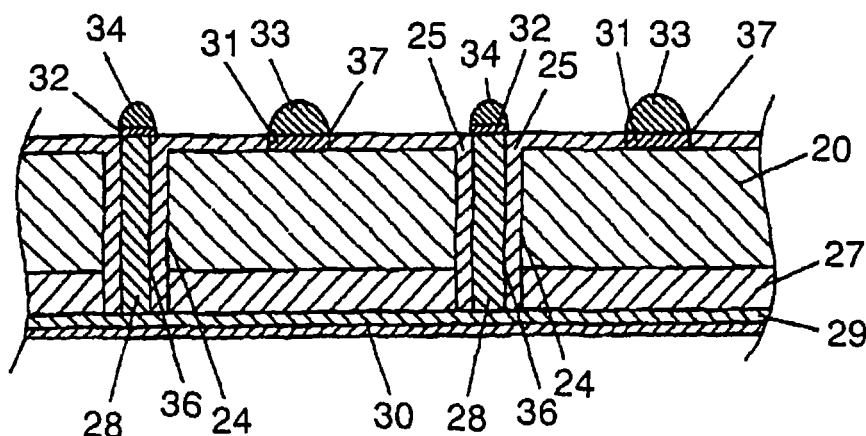
PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/009320 A1

- | | | |
|-----------------------------|--|---|
| (51) 国際特許分類: | H01G 9/00, 9/04, 9/012 | 市 小若江 2-9-4 6 Osaka (JP) 藤井 達雄 (FUJII,Tatsuo) [JP/JP]: 〒552-0001 大阪府 大阪市港区 波除 4-7-2-1 1 1 0 Osaka (JP). 中野 慎 (NAKANO,Makoto) [JP/JP]: 〒572-0055 大阪府 寝屋川市御幸東町 3-1 4-3 0 7 Osaka (JP) 木村 涼 (KIMURA,Suzushi) [JP/JP]: 〒561-0802 大阪府 豊中市曾根東町 2-5-3 Osaka (JP) |
| (21) 国際出願番号: | PCT/JP02/07218 | |
| (22) 国際出願日: | 2002 年7 月16 日 (16 07 2002) | |
| (25) 国際出願の言語: | 日本語 | |
| (26) 国際公開の言語: | 日本語 | (74) 代理人: 岩橋 文雄, 外(IWAHASHI,Fumio et al.): 〒571-8501 大阪府 門真市 大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内 Osaka (JP) |
| (30) 優先権データ: | 特願2001-216351 2001 年7 月17 日 (17.07.2001) JP | (81) 指定国 (国内): CN, JP, SG, US |
| (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): | 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]: 〒571-8501 大阪府 門真市 大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP) | (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR). |
| (72) 発明者: および | | 添付公開書類: |
| (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): | 三木 勝政 (MIKI,Katsumasa) [JP/JP]: 〒573-1145 大阪府 枚方市 黄金野 2-2 3-1 2 Osaka (JP). 御堂 勇治 (MIDO,Yuji) [JP/JP]: 〒577-0818 大阪府 東大阪 | — 国際調査報告書 |
| | | 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。 |

Title: PRODUCTION METHOD FOR SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR

* 1 発明の名称: 固体電解コンデンサの製造方法



(57) Abstract: A production method for a solid electrolytic capacitor excellent in high frequency characteristics and capable of mounting semiconductor components directly thereon. A first through hole (24) is formed after a resist film (23) is formed on one surface of an aluminum foil (20), then an insulation film (25) is formed so as to cover the other surface of the aluminum foil (20) and the inside of the first through hole (24) and then the resist film (23) is removed, a dielectric layer (27) is formed after the aluminum foil (20) is roughened, a second through hole (36) is formed inside the insulation film (25) filled in the first through hole (24), a through hole electrode (28) is formed in this second through hole and then a solid electrolytic layer (29) and further a collector layer (30) are formed on the surface of the dielectric layer (27), and, after an opening (37) is formed, a first terminal (31) is formed in the opening and a second terminal on the exposed surface of the through hole electrode (28).

〔続葉有〕

WO 03/009320 A1